

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月31日(31.08.2023)



(10) 国際公開番号

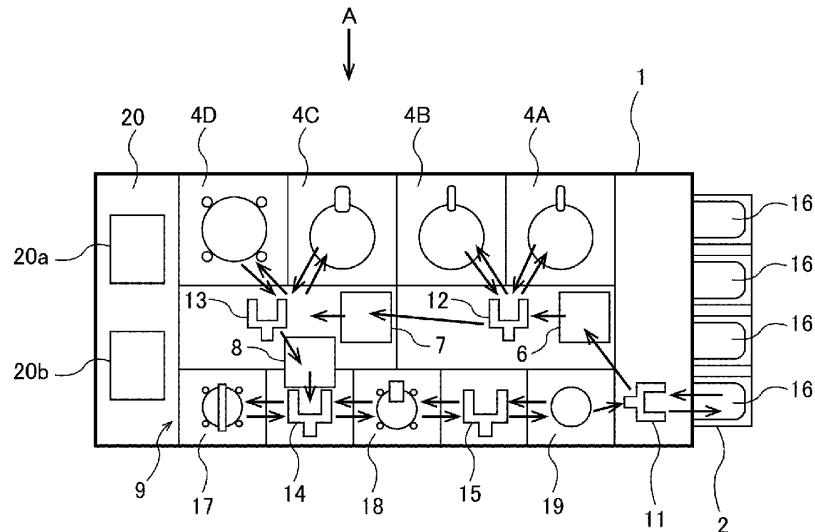
WO 2023/162714 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) B24B 21/00 (2006.01)
B24B 9/00 (2006.01) B24B 49/10 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/004509
- (22) 国際出願日: 2023年2月10日(10.02.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-027736 2022年2月25日(25.02.2022) JP
特願 2023-017612 2023年2月8日(08.02.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 谷澤 昭 尋 (YAZAWA, Akihiro); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 小林 賢一 (KOBAYASHI, Kenichi); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 大橋 弘 堯 (OHASHI, Hirotaka); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 石川 翔 (ISHIKAWA, Sho); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 柏木 誠 (KASHIWAGI, Makoto); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 宮澤 康之 (MIYASAWA, Yasuyuki); 〒1448510

(54) Title: SUBSTRATE POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板研磨装置

[図1]



(57) Abstract: The present invention pertains to a substrate polishing device for polishing a substrate such as a wafer, and particularly to a substrate polishing device for polishing a notch section of the substrate, a bevel section of the substrate, a device surface of the substrate, and the back surface of the substrate. This substrate polishing device includes a first polishing module, a second polishing module, and a third polishing module, and the first polishing module, the second polishing module, and the third polishing module are polishing modules respectively polishing different areas of the

[続葉有]

東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 廣澤 哲也, 外(HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

substrate.

(57) 要約: 本発明は、ウェーハなどの基板を研磨する基板研磨装置に関し、特に基板のノッチ部、基板のベベル部、基板のデバイス面、および基板の裏面の研磨を行う基板研磨装置に関するものである。基板研磨装置は、第 1 研磨モジュール、第 2 研磨モジュール、および第 3 研磨モジュールを備え、第 1 研磨モジュール、第 2 研磨モジュール、および第 3 研磨モジュールは、それぞれ基板の異なる領域を研磨する研磨モジュールである。